

1. Record Nr.	UNISA990006033720203316
Autore	GUBITOSI, Camillo
Titolo	Analisi della genesi storico-architettonica del Castel dell'Ovo in rapporto ai rilievi / Camillo Gubitosi
Pubbl/distr/stampa	[S.l.] : [s.n.], 1968 (Napoli : Giannini)
Descrizione fisica	43 p. : ill. ; 24 cm
Disciplina	728.81
Soggetti	Castel dell'Ovo - Storia - Architettura
Collocazione	FC.OE. 111
Lingua di pubblicazione	Italiano
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	Già pubblicato in: Quaderno n. 1 dell'Accademia Pontaniana
2. Record Nr.	UNISALENT0991001589209707536
Autore	Malamud, Bernard
Titolo	Gli inquilini / Bernard Malamud ; traduzione di Floriana Bossi
Pubbl/distr/stampa	Torino : Einaudi, c1972
Descrizione fisica	211 p. ; 22 cm.
Altri autori (Persone)	Bossi, Floriana
Lingua di pubblicazione	Italiano
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia

3. Record Nr.	UNINA9911020036703321
Autore	Raj Balwinder
Titolo	FeFET Devices, Trends, Technology and Applications
Pubbl/distr/stampa	Newark : , : John Wiley & Sons, Incorporated, , 2025 ©2025
ISBN	9781394287307 1394287305 9781394287284 1394287283 9781394287291 1394287291
Edizione	[1st ed.]
Descrizione fisica	1 online resource (353 pages)
Collana	Semiconductor devices and their applications
Altri autori (Persone)	Rahi Shiromani Balmukund Yadav Nandakishor
Disciplina	621.3815/284
Soggetti	Field-effect transistors Ferroelectric devices
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Sommario/riassunto	FeFET Devices, Trends, Technology and Applications is essential for anyone seeking an in-depth understanding of the latest advancements in ferroelectric devices, as it offers comprehensive insights into research techniques, novel materials, and the historical context of semiconductor development. This book serves as an encyclopedia of knowledge for state-of-the-art research techniques for the miniaturization of ferroelectric devices. This volume explores characteristics, novel materials used, modifications in device structure, and advancements in model FET devices. Though many devices following Moore's Law and More-Moore are proposed, a complete history of existing and proposed semiconductor devices is now available here. This resource focuses on developments and research in emerging ferroelectric FET devices and their applications, providing unique coverage of topics covering recent advancements and novel

concepts in the field of miniaturized ferroelectric devices.
